### **BEST AVAILABLE COPY**

9日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-287020

@Int_Cl_	ı	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和63年(	1988)11月24日
H 01 L	21/302 21/30 21/302	3 6 1	B-8223-5F R-7376-5F H-8223-5F	審査請求	未請求	発明の数	1 (全3頁)

**図発明の名称** レジスト除去装置

②特 顧 昭62-121227

②出 願 昭62(1987) 5月20日

72発 明者 野 哲 恕 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 小 作所中央研究所内 母発 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 明 加 雄 作所中央研究所内 ②発 眀 渚 Ш 純 男 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内 ⑫発 眀 者 宮 H 敏 光 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日ウ製 作所中央研究所内 の出願 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 死代 理 弁理士 小川 勝男 外1名 最終頁に続く

明· 翻 名

1、発明の名称

レジスト除去装置

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 反応室とその内部にある試料台と反応室に設 業の励起原子を生じさせる装置から成るレジスト除去装置において、試料台を試料表面が水平 面から約90°以上傾斜せしめて固定する手段 を設けたことを物徴とするレジスト除去装置。
  - 2. O1, O1, N1O, NO2 を業外級で分解 して酸素品起源子を生じさせる手段を有してな る第1項記載のレジスト除去装置。
  - 3. 前記試料台を、試料加工面を下方に向けて固定し得るように構成したことを特徴とする第1 項記載のレジスト除去装置。
- 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、飲料面にほこりが堆積しない構造と したレジスト除去数量に関する。

〔従来の技術〕

半導体製造工程の1つに用済みのレジストを除去する工程がある。この方法として、放射の励起原子でレジストを酸化除去するものが知られている。たとえば、ポリメア エンジニアリング アンド サイエンス第12階,第2号(1972年)第10月頁,(Pelymer Engineering and Science vo 12, 20, 20) p10月)には、オゾンを繋外線で分解し、これにより発生する放射の励起原子を用いてレジストを除去する方法が述べられている。これは変品等を使う過去の方法とよなり、変品廃棄物が出ない乾式法として注目されている。

〔発明が解決しようとする問題点〕

半導体製造プロセスは非常にほこりを嫌うものである。しかし、上記従来技術ではほこりを防ぐ 方法は考慮されていない。

本発明の目的は、ほこりの影響を少なく抑えた レジスト験去装置を提供することである。

【問題点を解決するための手段】

上記目的は試料を水平から約90。以上傾けて

遊屋することで解決できる。

(作用)

即ち、本発明は試料台を試料表面が水平より的 80°以上傾くように構成することにより、重力 部下による試料表面へのほこりの堆積を防止した ものである。

#### (実施例)

以下、本発明の実施例を図により説明する。

第1回はレジスト除去装置主要部の構成図である。第1回(a)は側面図、(b)は(a)のAーA新面図である。反応室1は気密封止されており、ガス供給ロ4から反応ガスが入れられる。ガスの種類は、O2 、O2 、N2O 、NO2 などである。ガスは排気口5より排気される。反応室内にはランプ2が設置されている。ランプは第外線を出すもので、たとえば185nm,254nmの波長の光を出す低圧水銀蒸気放電灯である。ランプ点灯回路は図では倍略されている。

試料台3は本発明に従がい、試料面がほぼ重直 になるようについている。試料台3は均一性をよ

第2回は別の実施例で、試料台3は従来とは逆に下方を向いている。この配置はほこりを助ぐには最も良い。また、第2回は常外線ランプの別の例として、マイクロ波を利用したものを示している。これは、金属第11と金属網12から成る空別共振器の中に無電極のランプ2を入れて、マイ

ラミツクを用いるのが最も良い。

くするための回転機構等がついている。試料6は たとえばレジストを強布されたシリコンウェハな どで、試料台3には気圧を利用して装着される。 すなわち試料台3には小孔7が開いており、そこ から其空ポンプで排気して試料6を台に吸引する ことで固定する。

上述の如き装置において、たとえばO』を反応 室に洗し、ランプに低圧水銀蒸気放電灯を用いた ときのレジスト酸去過程を説明する。O。は彼長 254nmの光により、次式のように分解する。

0 s - 0 s + 0 ·

〇・は酸素の励起原子で強い酸化力を持ち、有機物(油・レジスト)をH = 〇 や C O = 等に分解する。以上のようにして本数数ではシリコンウェハ上のレジスト等が除去できる。この過程の際、本数数では従来数数と異なり試料表面が重直に立つているので、ほこりが重力部下によつて堆積することができる。さらにほこりの堆積を少なくするためには、反応ガスを第1回のガス供給口4の矢

クロ被発援器10、導波管8により電力を供給するものである。13はランプ止めである。このランプ点灯方式は、ランプに電極が無いのでランプ 構造が簡単になる利点がある。さらに電極が無いためにランプ2内にヨウ素などの金属を侵す物質を封入し、紫外線の波長を変えることもできる。 図中8は石英板で、これは無くてもよいが、反応室内の酸素により金属額等が酸化されるのを防ぐ目的で入っている。

以上の実施例において、試料6の数者には、試料6の数をつかんで動かす自動機送器が用いられることがある。この場合、搬送器と試料台6の小孔7を真空に引くポンプを連動させて、試料6をはずすとき、真空吸引を止めるようにすれば良い。

また、レジストを除去するために酸素品起原子を発生する方法は光を使う方法の他にも、放電プラズマにより酸素を励起する方法等各種の変形が可能である。

#### 〔発明の効果〕

本発明によれば、試料表面へのほこりの堆積を

# **BEST AVAILABLE COPY**

特開昭63-287020(3)

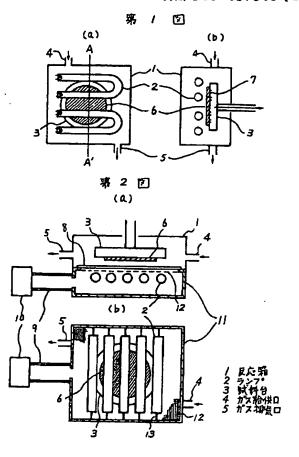
効果的に防ぐことができるので、積浄な試料を提供することができる。

### 4. 園面の簡単な説明

第1回,第2回は本発明の一実施例になるレジ、 スト除去装置の主要構成部の側面図および断面図 である。

1 … 反応箱、 2 … ランプ、 3 … 試料台、 4 … ガス 供給口、 5 … ガス排気口、 5 … 試料、 7 … 小孔、 8 … 石英板、 8 … 導放臂、 1 0 … マイクロ波発扱 器、 1 1 … 金属箱、 1 2 … 金属箱、 1 3 … ランプ 止め。

代理人 井理士 小川勝見



第1頁の続き

②発 明 者 舟 越 明 夫 東京都青梅市藤橋888番地 株式会社日立製作所青梅工場 内